№ 620

TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

УДК 535.37:546.221.57

Ю.И. Крусток, Я.Э. Мядассон, М.Э. Алтосаар

ПРИРОДА КРАСНОЙ ПОЛОСЫ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В CdS: Aq: Cl

Сульфид кадмия, легированный серебром, обладает при комнатной температуре ярко выраженной фотолюминесценцией (ФЛ) в красной области спектра с положением максимума при 750 нм (к-полоса ФЛ). Многие работы указывают на неэлементарность к-полосы. Так, в [1] показано, что CdS: Aq и CdS: Cl обладают несколько отличающимися К -полосами, которые имеют разную энергию активации температурного тушения. В работе [2] показано, что сульфид кадмия в К-области имеет несколько подполос с разными параметрами и разным характером электрон-фононного взаимодействия. Это подтверждается N другими работами [3-5], где в качестве разных моделей к-центров предложены (VcdVs), (AqcdVs), (AqcdCls) и др. По данным Гурвича [6] в красной области ФЛ расположено и излучение "самоактивированного" (CA) центра - (VcdCl3)'. Это согласуется данными работ [7-9].

В некоторых работах делается попытка объяснить особенности поведения ФЛ в красной области со сложной структурой к-центра, который взаимодействует с соседними центрами донорного (D) и акцепторного (A) происхождения, образуя комплекс в виде тримера D – A – K, см., например, [IO].

Относительно большое число предложенных моделей к-центра, а также различия в параметрах к-полосы ФЛ у разных авторов указывают на необходимость дальнейшего исследования в этом направлении.

В настоящей работе исследуется ФЛ CdS:Ag:Cl в красной полосе в зависмости от условий приготовления материала и, температуры измерения.

Исходным материалом служил порошок CdS (БКО 028014 ТУ), прошедший вакуумную сублимацию при 1073 К в течение З часов. К полученному материалу добавляли водный раствор Ад NO3. Диффузию Aq в кристаллиты CdS проводили при 1073 К в течение 24 часов в потоке H2S+H2 для удаления кислорода хлора. Легирование хлором проводили из фазы CdCl2. Легированные материалы подвергались термообработке при I000-1200 К, либо в двухзонных ампулах под разными давлениями паров компонентов, см. [6], либо в однозонных ампулах под "MTHOсобственным давлением паров материала с последующим венным" охлаждением. Из полученных таким образом материалов приготовляли образцы в виде наклеенных силикатным клеем на медные диски порошковых слоев строго одинаковых размеров. Образцы помещали в криостат, позволяющий изменять и поддерживать температуру от 80 до 400 К с точностью +I К. ФЛ возбуждали линией 365 нм ртутной лампы ДРШ-250 и измеряли с помощью монохроматора SPM-2 и ФЭУ-83. Методом притушенных наименьших квадратов [II] из спектров ФЛ выделяли к-полосу и определяли ее интенсивность, полуширину и положение максимума.



Рис. 1.

Зависимость положения максимума (a) и полуширины (δ) к-полосы Φ Л CdS:Ag:Cl от давления паров кадмия при 80 K 1 - [Ag] = = $3 \cdot 10^{18}$ см⁻³, [Cl] = $5 \cdot 10^{15}$ см⁻³, 2 - [Ag] = 10^{19} см⁻³, [Cl] = = $3 \cdot 10^{16}$ см⁻³, 3 - [Ag] = 10^{16} см⁻³, [Cl] = $3 \cdot 10^{17}$ см⁻³.

Проведенные исследования показали, что параметры К-полосы в значительной мере зависят от давления паров кадмия. Это хорошо видно из рис. I, где приведены зависимости положения максимума и полуширины к-полосы при 80 К от давления

паров кадмия для образцов, легированных разными концентрациями серебра и хлора и прокаленных при температуре II23 К. У всех образцов наблюдаются резкие изменения в параметрах к--полосы. Такие изменения можно объяснить как переходы от одной к-полосы к другой с резким изменением положения максимума и полуширины. Для каждого образца можно выделить длинноволновую (К,) и коротковолновую (К,) к-полосы, причем полуширина полосы (K2) намного превосходит полуширину полосы K1. Нами было проделано несколько серий опытов для выяснения зависимостей параметров к-полос от концентрации серебра и хлора. При повышении концентрации хлора положение максимумов Кт и К2-полос смещается в сторону меньших энергий и полуширины их уменьшаются. Некоторые изменения в параметрах к -полос наблюдаются и при повышении концентрации серебра, однако они намного меньше, чем изменения, вызванные хлором. Поэтому можно предположить, что наблюдаемые различия в параметрах К,- и К2-полос разных образцов связаны с различной концентрацией хлора.

Из рис. І видно, что если концентрация серебра больше концентрации хлора, то K₂-полоса выделяется только при малых давлениях паров кадмия. В противоположном случае K₂полосу можно обнаружить при давлениях паров кадмия P_{Cd} < p_{мин}, соответствующих избыточному давлению паров серы. Такое поведение указывает на различную химическую природу центров свечения, ответственных за K₄-и K₂-полосы ФЛ.

Наличие к-центров различной природы подтверждается и измерениями температурной зависимости параметров к-полосы, которые приведены на рис. 2, 3. На рис. 3 можно выделить участки, где зависимость полуширины к-полосы от температуры описывается в рамках модели конфигурационных координат формулой

$$W = W(0) [\operatorname{coth}(\hbar \omega / 2\kappa T)]^{\prime \prime},$$

где W(0) = 2(2ln 2)^{1/2} S^{1/2} ħω - значение полуширины при T = 0 К; S - среднее число фононов, сопровождающих излучательный электронный переход;

ћω - энергия "эффективного" фонона возбужденного состояния.

Вычисленные значения S, ħ ω для к-центров приведены в таблице. Характер зависимости параметров к-полосы от темпера-



Рис. 2. Зависимость положения максимума к-полосы ФЛ CdS: Ag: Cl от температуры 1 – [Ag] = $3 \cdot 10^{18}$ см⁻³, [Cl] = $5 \cdot 10^{15}$ см⁻³, P₅₂ = $2,5 \cdot 10^4$ Па, 2 – [Ag] = $3 \cdot 10^{18}$ см⁻³, [Cl] = $5 \cdot 10^{15}$ см⁻³, P_{cd} = $4,6 \cdot 10^3$ Па, 3 – [Ag] = $3 \cdot 10^{17}$ см⁻³, [Cl] = $4,7 \cdot 10^{18}$ см⁻³ P_{cd} = P_{мин}.



Рис. 3.

Зависимость полуширины к-полосы ФЛ CdS:Ag:Cl от температуры. (Обозначение образцов см. рис.2).

Таблица

Параметры к-полос ФЛ CdS: Aq: Cl при T = I50 К

Полоса	hv max 9B	W эВ	W(0) 9B	ħω 9B	S	N.
K ₁	I,662	0,253	0,228	0,0305	IO,I	
K ₂	I,7I7	0,354	0,350	0,0612	5,9	

туры у образца I (рис. 2, 3) при 80-I24 К и 230-330 К свидетельствует о переходе от одной к -полосы к другой с перераспределением интенсивности, поскольку в суммарной интенсивности к -полосы не наблюдается изменений в этих областях температур. Это дает возможность вычислить энергии активации для этих переходов. Для переходов $K_1 - K_2$ и $K_2 - K_1$ получаются энергии активации 0,06 эВ и 0,64 эВ соответственно. Такие переходы можно представить как туннелирование носителей заряда между центрами с преодолением определенного барьера. Очевидно, что такие туннельные переходы носителей между центрами возможны только при относительно близком расположении этих центров, что указывает на сложную комплексную природу к-центра, в состав которого могут входить атомы разных элементов.

Как видно из рис. 2, 3, K_2 -полоса проявляется наиболее отчетливо в материалах, легированных при условии $N_{Aq} >> N_{Cl}$ под избыточным давлением паров серы. С повышением давления паров кадмия относительная доля K_2 -полосы уменьшается. Характерно, что при легировании в условиях $N_{Cl} \ge N_{Aq}$ под собственным давлением паров компонентов наблюдается только полоса K_1 (см. рис. 2, 3).

Полученные энергии "эффективных" фононов для K₁-и K₂центров позволяют сделать некоторые выводы относительно отношения масс этих центров. Так как в простейшей модели колебаний частота колеблющейся системы ω выражается

$$=\sqrt{k/m}$$
,

где k - упругая постоянная;

m - масса системы,

то при постоянстве упругой постоянной отношение квадратов "эффективных" частот колебаний центров должно равняться отношению масс этих центров. По данным таблицы получается m_{к/}m_{к2} = 4,03.

На основе полученных результатов можно предположить, что K_1 -центром является нейтральный комплекс $(Ag_{Cd}Cl_S)^{\times}$ и K_2 -центром — комплекс $(V_{Cd}Cl_S)'$, т.е. это СА-центр в сульфиде кадмия. Действительно в таком случае $m_{K_1}/m_{K_2}=(M_{Ag}+M_{Cl})/M_{Cl}=$ = 4,04, что хорошо согласуется с полученным выше результатом. Доминирование СА-полосы при малых давлениях паров кадмия при условии $N_{Cl} \ge N_{Ag}$ согласуется с данными работ [12, 9]. Подтверждается выдвинутое в [13] предположение о неидентичной природе к -центров в сульфиде кадмия, легированном серебром или медью, так как комплекс типа $(Cu_{Cd}Cl_S)^{\times}$ в CdS: Cu: Cl является центром, ответственным за излучение в инфракрасной области спектра [14]. Аналогичный K_1 -центру комплекс типа (Cu_{zn}Cl_s)[×] является G-Cu -центром в ZnS:Cu:Cl [I5].

Литература

I. Келле Х.Й., Кирс Я.Я., Тулва Л.Т. О происхождении оранжевой и красной люминесценции сульфида кадмия. - Труды ИФА АН ЭССР, 1972, т. 41, с. 129-145.

2. Ermolovich I.B., Matvievskaja G.I., Sheinkman M.K. Electron-phonon interactions of radiative carrier capture on deep centers in CdS single crystals. - J. Luminescence, 1975, v. 10, p. 58-68.

З. Ермолович И.Б., Матвиевская Г.И., Пекарь Г.С., Шейнкман М.К. Люминесценция монокристаллов CdS, легированных различными донорами и акцепторами. - УФЖ, 1973, т. 18, с. 732-741.

4. Шейнкман М.К., Корсунская Н.Е. Маркевич И.В., Торчинская Г.В. Механизмы излучательных и безызлучательных переходов в соединениях A^{II}B^{YI} и природа центров свечения. - Изв. АН СССР, сер. физ., 1976, т. 40, № II, с. 2290-2297.

5. C o l b o w K., Y u e n K. Radiative recombination in cadmium sulfide. - Can. J. Physics, 1972, v. 50, N 13, p. 1518-1538.

6. Гурвич А.М. Введение в физическую химию кристаллофосфоров. М.: Высшая школа, 1982. 376 с.

7. Shiraki Y., Shimada T., Komatsubara K.F. Optical studies of deep-center luminescence in CdS. - J. Appl. Phys., 1974, v. 45, N 8, p. 3554-3561.

8. Susa N., Watanabe H., Wada M. Self-activated emission in CdS. - Japan J. Appl. Phys., 1976, v. 15, N 12, p. 2463-2464.

9. Susa N., Watanabe H., Wada M. Effects of annealing in Cd or S vapor on photoelectric properties of CdS single crystals. - Japan J. Appl. Phys., 1976, v. 15, N 12, p. 2365-2370.

IO. Богданюк Н.С., Галушка А.П., Ос-

тапенко С.С., Шейнкман М.К. Механизм вспышки "красной" люминесценции в облученных электронами монокристаллах СdS.-ФП, 1984, т. 18, № 2, с. 305-311.

11. Papoušek D., Pliva J. Mathematical resolution of overlapping spectrum lines by the method of damped least squares. - Collection Czech. Chem. Commun., 1965, v. 30, N 9, p. 3007-3015.

I2. Алтосаар М.Э., Кукк П.Л., Хийе Я.В. Растворимость хлора в CdS и структура точечных дефектов в CdS:Cl. – Ж. неорганич. химии, 1983, т. 28, № I, с. 69-75.

13. Мядассон Я.Э., Крусток Ю.И., Алтосаар М.Э. Дефектный состав порошкового сульфида кадмия с примесью серебра и хлора. - В кн.: Тезисы докладов IУ Всесоюзного совещания по химии твердого тела. Часть Ш., Свердловск, 1985, с. 132.

I4. Kukk P., Erm A. The structure of radiative and non-radiative recombination centres in activated CdS phosphors. - Phys. Stat. Sol. (a), 1981, v. 67, p. 395-406.

I5. Кукк П.Л., Крусток Ю.И., Эрм А.Я., Мядассон Я.Э., Моин М.Д. Структура точечных дефектов в примесном сульфиде цинка. - Ж. неорганич. химии, 1984, т. 29, № I, с. 46-50.

J. Krustok, J. Madasson, M. Altosaar

The Nature of Red-Band Photoluminescence in CdS:Ag:Cl

Abstract

The behaviour of red-band photoluminescence in dependence on doping level (Ag and Cl concentrations) and preparing conditions (annealing in Cd and S vapour) and also the measuring temperature have been studied in CdS:Ag:Cl. It was possible to separate a long wavelength (K1) and a short wavelength (K2) sub-bands for every material the behaviour of which indicates to the different nature of recombination centres. The fact is confirmed by the temperature dependence on the red-band parameters. The transition barriers for $k_1 \rightarrow k_2$ (0.06 eV) and for $k_2 \rightarrow k_1$ (0.64 eV) are calculated. These transitions may be treated as the tunneling of electrons between closely neighbouring centres indicating to the complex nature of the red-band photoluminescence centre. The k1-centre may be identified with the neutral defect of the CdS lattice as $(Ag_{Cd}Cl_S)^X$ and the k2-center as V" Cl. Cd S

30